

## SKY LANE スカイレーン Plating Using the Full Auto Equipment 自動めっき装置

銅めっき、Niめっき、Auめっきの複合めっきが可能な最新の半導体装置です。

銅とニッケルのアノードのプロセスコストが大幅に削減され、金のプロセスコストも大幅に削減できます。

当社独自のオールラウンドコンタクト  
ウエハへの優れた電流分布、  
高速めっきが可能であり、めっきの均一性にも優れています。

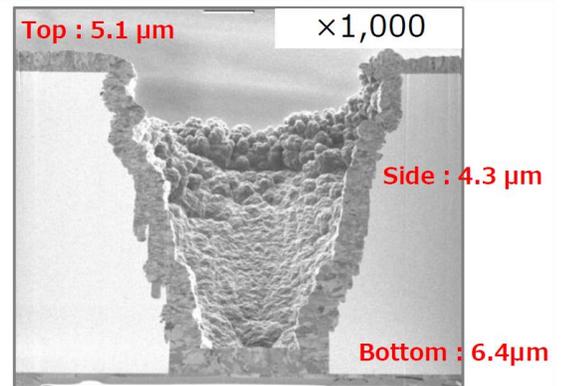
### Applications

- ウエハレベルのパッケージング
- フリップチップ相互接続
- はんだバンピング（ニッケル&はんだメッキ付）
- CAバンブ
- ボンディングなど



ウエハ処理の Solstice プラットフォームは、必要なアプリケーションに応じて、カスタマイズ可能な構成で 8 チャンバー、4 チャンバー、3 チャンバー、または 2 チャンバーで利用できます。

### Thickness uniformity in a wafer via



High-uniformity gold plating from the SKY LANE

### Features

- フェイスダウンめっきチャンバー
- 全周コンタクトリング
- 自動液補給ソリューションシステム
- ダブル（ドライ&ウェット）ハンドスカロボット
- 8インチ×8チャンバーシステム
- 2 スピンリンスドライヤー

Technical Spec	
ウエハ サイズ	150-200mm
ウエハ タイプ	Notch / Flat
ウエハ 厚み	200 $\mu$ m to >6mm
ウエハ 材質	Silicon GaAs GaN on Si, GaN on Sapphire Sapphire Transparent substrates and more
チャンバー数	8 chamber
装置サイズ8C	W2300×L4200×H2200(mm)
制御盤サイズ	W800×L800×H2000(mm)
電源	220V 3P 125A
めっきタンク容量	70 $\ell$
温度制御	$\pm 2^{\circ}\text{C}$
整流器電源容量	20A
流量コントロール	25 lpm
めっき速度	>3 $\mu$ m/minute, up to 6.5 $\mu$ m/minute(※about)
ウエハ膜厚均一性	<5% (range 2*mean)
ウエハ間膜厚均一性	<5% (mean-to-mean)
対応電流値	0.2Å on 20Å seed deplate
平面性	<5%
通信仕様	Ethernet and CC Link

## UI SCIENCE CO.,LTD

1059-5 TAKATA KASHIWA CTIY CHIBA JAPAN 〒277-0861  
TEL 04-7137-7383 FAX 04-7137-7384  
e-mail s\_umemoto@ui-science.co.jp  
<http://www.ui-science.com/>